

電子材料研究会

〔委員長〕川浪仁志（産総研）

〔副委員長〕奥村次徳（都立大）

〔幹事〕岡田至崇（筑波大），羽路伸夫（横浜国大）

日時 6月19日（水）10:20～16:45

場所 東京工業大学大岡山キャンパス百年記念館4階、フェライト記念会議室（東京都目黒区大岡山2-12-1，東急大井町線・目黒線(地下鉄南北線・三田線直通)大岡山駅前）

協賛 誘電体薄膜材料調査専門委員会（委員長 奥山雅則，幹事 阿部和秀，野田 実，山本直樹）

議題 テーマ「強誘電体薄膜とデバイス応用」

10:20～11:50

EFM-02-9 エピタキシャル薄膜を用いたPZT薄膜の結晶構造と特性評価

舟窪 浩，及川貴弘（東工大），斎藤啓介（日本フィリップス）

EFM-02-10 自然超格子構造を有する強誘電体 $\text{Bi}_4\text{Ti}_3\text{O}_{12}$ - $\text{SrBi}_4\text{Ti}_4\text{O}_{15}$ エピタキシャル薄膜の作製

渋谷 明，野田 実，奥山雅則（大阪大）

EFM-02-11 ラマン分光法による強誘電体材料の評価

長田 実（東工大，科学技術振興事業団さきがけ研究21），垣花真人（東工大）

13:00～16:45

EFM-02-12 コンビナトリアル手法を用いた強誘電体/Si界面の構造安定化

知京豊裕，Yoo YoungZu，金 政武，パールハット=アヘメト
中島清美，成毛環美，鯉沼秀臣（物質材料研究機構，東工大）

EFM-02-13 インクジェットプリント法を用いた強誘電体薄膜材料の系統的高速探索法

岡村総一郎，竹内理恵，塩寄 忠（奈良先端科技大）

EFM-02-14 高誘電率バッファ層を用いたMFIS構造の界面特性

藤崎芳久，石原 宏（東工大）

EFM-02-15 $\text{YMnO}_3/\text{Y}_2\text{O}_3/\text{Si}$ エピタキシャル構造を用いたMFISキャパシタの物性

藤村紀文，伊藤大輔，伊藤太一郎（大阪府立大）

EFM-02-16 擬似マトリクス型強誘電体メモリ

西原利幸，伊藤康幸（ソニー）

EFM-02-17 混載を睨んだ強誘電体メモリのソリューション

豊島秀雄（NEC）

EFM-02-18 強誘電体デバイスを用いた機能パスゲートと低電力VLSIへの応用

木村啓明，羽生貴弘，亀山充隆（東北大）

藤森敬和，中村 孝，高須秀視（ローム）